

	<h2 style="color: #E67E22;">MVB50P03HDLT4G</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: MVB50P03HDLT4G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: INTEGRATED CIRCUIT
	Datenblätter:  MVB50P03HDLT4G.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	







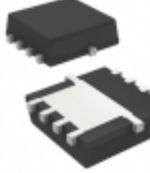

Spezifikationen

Teilenummer	MVB50P03HDLT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	INTEGRATED CIRCUIT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±15V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK-3
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 25A, 5V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4.9nF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 50A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

MVB50P03HDLT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MVB50P03HDLT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MVB50P03HDLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MVB50P03HDLT4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  MVB20040CT IGBT Module IGBT Modules	 STFU16N65M2 STMicroelectronics MOSFET	 SI2323DDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23	 MVBC01 BOMBARDIE BOMBARDIE QPF100
 FDD4685_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 32A DPAK	 IPI80N03S4L03AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO262-3	 SIS435DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 30A 1212-8	 MVBF170LT1G O O SOT-23

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MVB50P03HDLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	MVB50P03HDLT4G Datenblatt	MVB50P03HDLT4G-Datenblätter	MVB50P03HDLT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MVB50P03HDLT4G
MVB50P03HDLT4G Electronic	MVB50P03HDLT4G-Komponenten	MVB50P03HDLT4G-Verteiler	MVB50P03HDLT4G-Bild	MVB50P03HDLT4G-Teil
MVB50P03HDLT4G Preis	MVB50P03HDLT4G Hersteller	MVB50P03HDLT4G Bild	MVB50P03HDLT4G Aktie	MVB50P03HDLT4G Inventar
MVB50P03HDLT4G Neu	MVB50P03HDLT4G Original	MVB50P03HDLT4G garantiert	MVB50P03HDLT4G RFQ	MVB50P03HDLT4G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited